

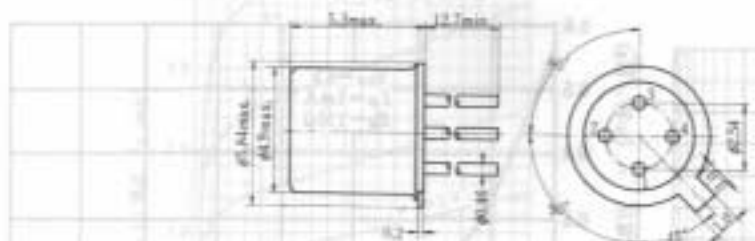
3SK21H

シリコン N チャンネル MOS FET

チョップ用

SILICON N-CHANNEL MOS FET

CHOPPER



1. ソース : Source
 2. ゲート 1 : Gate 1
 3. ドレイン : Drain
 4. ゲート 2 : Gate 2
- (Dimensions in mm)

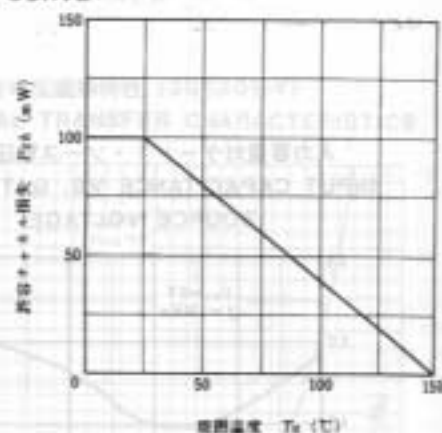
(JEDEC TO-72)

■ 絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (Ta=25℃)

項目	Symbol	3SK21H	Unit
ドレイン・ソース電圧	V _{DS} *	20	V
ゲート 1・ソース電圧	V _{G1S} **	+5 -20	V
ゲート 1・ソース破壊電圧	V _{G1SO}	±20	V
ドレイン電流	I _D	10	mA
許容チャンネル損失	P _{ch}	100	mW
チャンネル温度	T _{ch}	150	℃
保存温度	T _{stg}	-55~+150	℃

- * V_{G1S} = -6V における許容値
- ** V_{DS} = 1V における許容値
- * Value at V_{G1S} = -6V
- ** Value at V_{DS} = 1V

許容チャンネル損失の周囲温度による変化 MAXIMUM CHANNEL DISSIPATION CURVE



■ 電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25℃)

項目	Symbol	Test Condition	min	typ	max	Unit
ドレイン・ソース破壊電圧	V _{DSS}	I _D = 10μA, V _{G1S} = -6V, V _{G2S} = 0	20	-	-	V
ゲート 1 遮断電流	I _{G1S}	V _{G1S} = -6V, V _{DS} = V _{G2S} = 0	-	-	-1.0	μA
ゲート 1 遮断電圧	V _{G1SOFF}	I _D = 10μA, V _{DS} = 6V, V _{G2S} = 0	-	-	-6.0	V
ドレイン電流	I _{DSS}	V _{DS} = 6V, V _{G1S} = V _{G2S} = 0	3	-	16	mA
順伝達アドミタンス	g _o	V _{DS} = 6V, V _{G1S} = V _{G2S} = 0, f = 1kHz	2.5	-	-	mS
入力容量	C _{iss}	V _{DS} = 6V, V _{G1S} = V _{G2S} = 0, f = 1MHz	-	5.0	-	pF
オン抵抗	R _{ON}	V _{DS} = 0.1V, V _{G1S} = V _{G2S} = 0	-	250	300	Ω
オフ抵抗	R _{OFF}	V _{DS} = 0.1V, V _{G1S} = -6V, V _{G2S} = 0	100	-	-	MΩ